
	<h2>SIS429DNT-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIS429DNT-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 20A POWERPAK1212</p> <p>Datenblätter:  SIS429DNT-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 22605 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

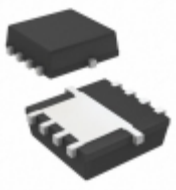
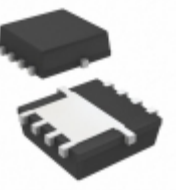


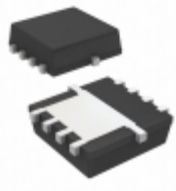
Spezifikationen

Teilenummer	SIS429DNT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 20A POWERPAK1212
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22605 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 10.5A, 10V
Verlustleistung (max)	27.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 20A (Tc) 27.8W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

SIS429DNT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS429DNT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS429DNT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS429DNT-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS427EDN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 50A 1212-8</p>	 <p>SIS426DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 35A 1212-8</p>	 <p>SIS430DN VISHAY SIS430DN VISHAY</p>	 <p>SiS429DNT-T1-GE3 VISHAY VISHAY DFN3*3</p>
 <p>SIS430DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS426DN-T1-E3 VISHAY SIS426DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIS430DN-T1-E3 VISHAY SIS430DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIS427EDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 50A 1212-8</p>

SIS429DNT-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SIS429DNT-T1-GE3 Datenblatt	SIS429DNT-T1-GE3-Datenblätter	SIS429DNT-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIS429DNT-T1-GE3 (EFI) / Vishay	SIS429DNT-T1-GE3 Komponenten	SIS429DNT-T1-GE3-Verteiler	SIS429DNT-T1-GE3-Bild	SIS429DNT-T1-GE3-Teil
SIS429DNT-T1-GE3 Electronic	SIS429DNT-T1-GE3 Hersteller	SIS429DNT-T1-GE3 Bild	SIS429DNT-T1-GE3 Aktie	SIS429DNT-T1-GE3 Inventar
SIS429DNT-T1-GE3 Preis	SIS429DNT-T1-GE3 Original	SIS429DNT-T1-GE3 garantiert	SIS429DNT-T1-GE3 RFQ	SIS429DNT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited